

S1ZB□

800V 0.8A

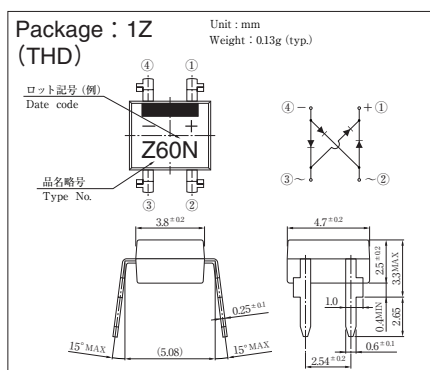
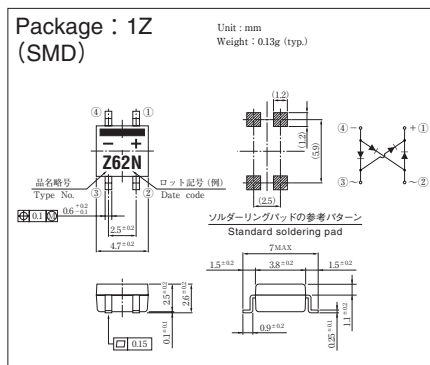
特長

- 小型DIPパッケージ
- 耐久性に優れ高信頼性
- 自動実装対応

Feature

- Small-DIP
- High-Reliability
- for Auto-Mount

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

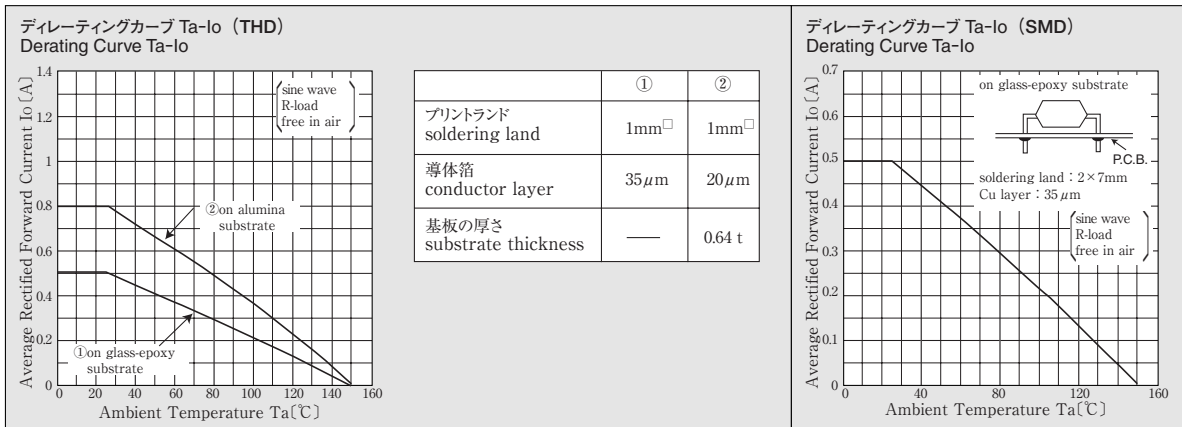
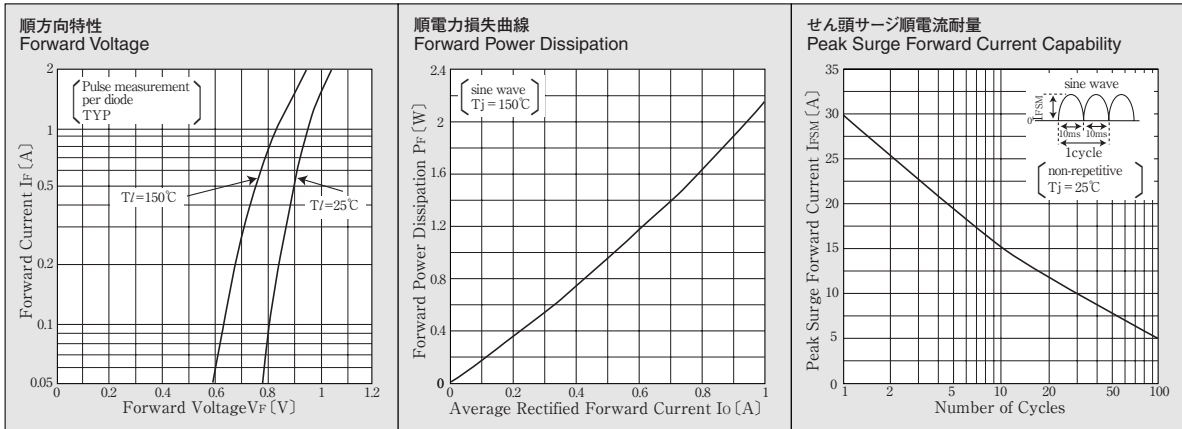
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZB□			単位 Unit
				20	60	80	
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40~150			$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150			$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	アルミナ基板実装, $T_a = 25^\circ\text{C}$ On alumina substrate, $T_a = 25^\circ\text{C}$ プリント基板実装, $T_a = 25^\circ\text{C}$ On glass-epoxy substrate, $T_a = 25^\circ\text{C}$	0.8			A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		30			A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$		4.5			A^2s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 0.4\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 20	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 76 MAX 134	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.